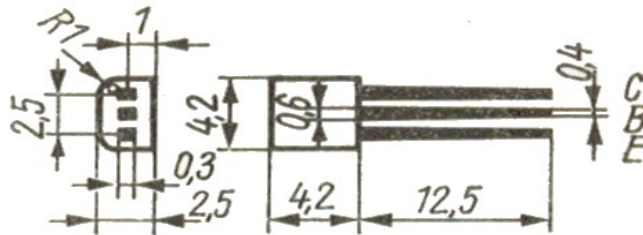


RFT SC307 – SC308 – SC309

Silizium- pnp- Planar- Epitaxie- Transistoren für den Einsatz in NF- Vor- und Treiberstufen sowie universelle Anwendungen

SC309 speziell für rauscharme Vor- und Treiberstufen



Wärmewiderstand $R_{thja} \leq 0,5K/mW$

Grenzwerte gültig für den Betriebstemperaturbereich

	SC308	SC309	SC307
U_{CBO}	= 30V	30V	50V
U_{CEO}	= 25V	25V	45V
U_{EBO}	= 5V	5V	6V
I_C	=		100mA
I_{CM}	=		200mA
P_{tot}	= (bei $\vartheta_a = 25^\circ C$)		250mW
ϑ_j	=		+150°C
ϑ_a	=		-40 ... +100°C

Statische Kennwerte ($\vartheta_a = 25^\circ C -5K$)

I_{CBO}	(bei $U_{CB} = 30V$)	SC308, SC309	\leq	100nA
I_{CBO}	(bei $U_{CB} = 45V$)	SC307	\leq	100nA
$U_{(BR)CEO}^{1)}$	(bei $I_C = 2mA$)	SC308, SC309	\geq	25V
		SC307	\geq	45V
U_{CEsat}	(bei $I_C = 100mA, I_B = 2mA$)		typ.	430mV
U_{BE}	(bei $U_{CE} = 6V, I_C = 0,1mA$)		typ.	565mV
U_{BE}	(bei $U_{CE} = 6V, I_C = 2mA$)		typ.	645mV
U_{BE}	(bei $U_{CE} = 6V, I_C = 20mA$)		typ.	720mV

¹⁾ Impulsmässige Messung

RFT SC307 – SC308 – SC309

Dynamische Kennwerte ($\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5\text{K}$)

f_T	(bei $U_{CE} = 5\text{V}$, $I_C = 10\text{mA}$ $f = 20\text{MHz}$)		typ.	350MHz
F	(bei $U_{CE} = 6\text{V}$, $I_C = 0,2\text{mA}$, $f=1\text{kHz}$, $\Delta f = 100\text{Hz}$, $R_G = 2\text{k}\Omega$)	SC307, SC308	\leq	8dB
F	(bei $U_{CE} = 6\text{V}$, $I_C = 0,2\text{mA}$, $f = (0,03 \dots 15) \text{kHz}$, $R_G = 2\text{k}\Omega$)	SC309	typ. max.	1,2dB 4dB
C_{11b}	($U_{EB} = 0,5\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$)			10pF
C_{22b}	($U_{CB} = 6\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$)			5,6pF
h_{21e}	(bei $U_{CE} = 6\text{V}$, $I_C=2\text{mA}$, $f=1\text{kHz}$)	Gruppe c Gruppe d Gruppe e Gruppe f		56 ... 140 112 ... 280 224 ... 560 450 ... 1120

www.semicon-data.de

Quelle: Aktive elektronische Bauelemente – 1985